

**ナノテクノロジープラットフォーム
研究支援に提供する設備一覧
【微細加工プラットフォーム】**

機関名	設備(設備群)名	仕様	備考
東京工業大学	電子ビーム露光装置 (スピニング・ホットプレート・オープン・ドラフトチャンバ等を含む)	JEOL JBX-6300SJ ビーム径10nm以下、位置合わせ精度3nm以下	
東京工業大学	電子ビーム露光データ加工ソフトウェア	GenISys BEAMER/ JEOL01.51.52などの日本電子製電子ビーム露光用パターンデータファイルが入出力可能。 各露光基板形状に基づいたモンテカルロシミュレーションによって点拡がり関数(PSF)を導出でき、得られたPSFに基づく近接効果補正が可能であること。	
東京工業大学	走査型電子顕微鏡	日立S5200 高解像度用インレンズ式	
東京工業大学	マスクレス露光装置	マスクレス露光装置 大日本科研製 MX-1204 DMDによるパターン生成露光、150mm角露光サイズ、最小描画画素1um、アラメント精度±0.15um	
東京工業大学	FIB-SEMデュアルビーム加工観察装置	JEOL製 JIB-4501 FIB部分 Ga 液体金属イオン源、加速電圧 1-30kV、ビーム電流最大60nA以上 SEM部分 加速電圧0.3-30kV 分解能 3nm以下 TEM用試料の自動加工およびメッシュへの移動が可能であること	
東京工業大学	原子層堆積装置	Ultratech/CambridgeNanotech製 Fijif200 ロードロック機構付 プラズマ式/サーマル式の両方のモードでの原子層堆積が可能。4プレカークサライン・4プラズマガスライン。酸素源:オゾンおよび水の両方の利用が可能	
東京工業大学	高真空蒸着装置	エイコーエンジニアリング製 ロードロックチャンバ付 6連E-gun	
東京工業大学	コンタクト光学露光装置	Süss MA-8	
東京工業大学	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ製 RIE-10NR	
東京工業大学	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ製 RIE-10NR	
東京工業大学	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ製 RIE-10NR	
東京工業大学	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ製ICP-RIE 装置	
東京工業大学	プラズマCVD 装置	シリコン酸化膜 サムコPD-240 1	
東京工業大学	プラズマCVD 装置	シリコン酸化膜 サムコPD-100ST	
東京工業大学	高真空蒸着装置	エイコーエンジニアリング製 ロードロックチャンバ付 6連E-gun	
東京工業大学	走査型電子顕微鏡	S-4500 電界放射型	
東京工業大学	触針式段差計	KLA テンコール P-7	
東京工業大学	低真空 SEM	キーエンス VHX-D510	
東京工業大学	デジタル顕微鏡	キーエンスVHX- 1000	
東京工業大学	スパッタ成膜装置	金属用 ロードロックチャンバ 付き	
東京工業大学	スパッタ成膜装置	絶縁膜用	
東京工業大学	基板貼付け装置	アユミ VE-07-18	
東京工業大学	ウェハ洗浄装置	EVG301	
東京工業大学	有機金属気相成長装置	日本酸素製 HR-3246 InP用	
東京工業大学	プラズマCVD装置	シリコン窒化膜/アモルファスシリコンの成膜 住友精密工業 Multiplex-CVD	
東京工業大学	化合物半導体光素子用酸化炉	最大温度500C(プログラム温調可) 基板サイズ最大2インチ	
東京工業大学	スパッタ成膜装置	対向ターゲット式RFスパッタリング(2元)	
東京工業大学	C-Vプロファイラ	Bio-rad POLARON PN4200	
東京工業大学	ダイシングソー	ディスコ DAD322 φ6インチ 切削可能範囲 x軸160mm y軸162m z軸32.2mm(φ2"ブレード時) Si用ブレード(NBC-Z1060)以外のブレードは基本自己負担	